



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108269529 A

(43)申请公布日 2018.07.10

(21)申请号 201810159372.7

(22)申请日 2018.02.24

(71)申请人 武汉华星光电半导体显示技术有限公司

地址 430000 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物创新园C5栋305室

(72)发明人 李双

(74)专利代理机构 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) 44280

代理人 钟子敏

(51)Int.Cl.

G09G 3/3225(2016.01)

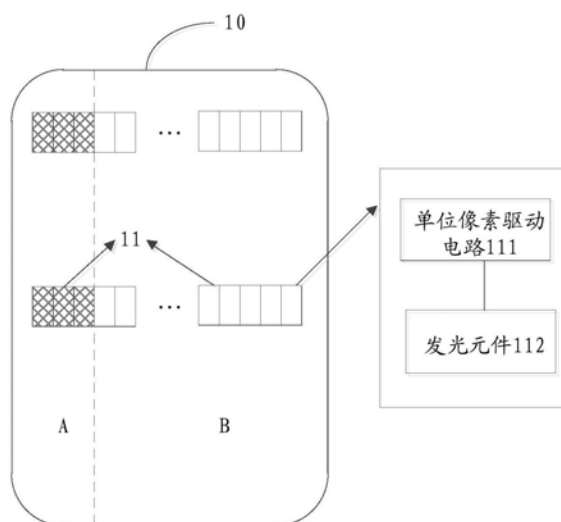
权利要求书2页 说明书6页 附图6页

(54)发明名称

一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板

(57)摘要

本发明公开了一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板。该面板至少包括膜层厚度不同的第一区域和第二区域；其中，设置在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中的存储电容具有不同的电容值，以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。本发明通过不同膜层厚度的区域设置不同的存储电容值，而不同的存储电容值对应的像素点的显示亮度不同，从而能够改善膜厚不均而导致的AMOLED面板显示亮度不均的问题，进而提升AMOLED的显示品质。



1. 一种AMOLED面板,其特征在于,所述面板至少包括膜层厚度不同的第一区域和第二区域;

其中,设置在所述第一区域和所述第二区域的单位像素驱动电路中的存储电容具有不同的电容值,以使所述第一区域和所述第二区域具有相同的显示亮度。

2. 根据权利要求1所述的面板,其特征在于,当所述第一区域的膜层厚度大于所述第二区域的膜层厚度时,设置在所述第一区域的所述存储电容的电容值大于设置在所述第二区域的所述存储电容的电容值。

3. 根据权利要求1所述的面板,其特征在于,所述第一区域为线蒸镀源蒸镀所述AMOLED面板时相邻喷嘴蒸镀的重叠蒸镀区域,所述第二区域为单个喷嘴蒸镀的非重叠蒸镀区域,其中,所述第一区域的膜层厚度大于所述第二区域的膜层厚度。

4. 根据权利要求1所述的面板,其特征在于,所述第一区域为线蒸镀源蒸镀所述AMOLED面板时第一蒸镀温度对应的蒸镀区域,所述第二区域为第二蒸镀温度对应的蒸镀区域,其中,当所述第一蒸镀温度高于第二蒸镀温度时,所述第一区域的膜层厚度大于所述第二区域的膜层厚度。

5. 根据权利要求3或4所述的面板,其特征在于,当所述第一区域和/或所述第二区域为多个时,所述第一区域和所述第二区域间隔设置在所述面板上。

6. 根据权利要求1所述的面板,其特征在于,设置在所述第一区域的第一存储电容由设于基板上的第一极板、位于所述第一极板上方的第一对向极板、夹持于所述第一极板和所述第一对向极板之间的绝缘层构成,设置在所述第二区域的第二存储电容由设于基板上的第二极板、位于所述第二极板上方的第二对向极板、夹持于所述第二极板和所述第二对向极板之间的绝缘层构成;

其中,所述第一极板的面积不同于所述第二极板的面积。

7. 根据权利要求6所述的面板,其特征在于,当所述第一极板的面积大于所述第二极板的面积时,所述第一存储电容的电容值大于所述第二存储电容的电容值。

8. 根据权利要求1所述的面板,其特征在于,所述单位像素驱动电路包括第一薄膜晶体管、第二薄膜晶体管、第三薄膜晶体管、第四薄膜晶体管、第五薄膜晶体管、第六薄膜晶体管、第七薄膜晶体管和存储电容;

所述第二薄膜晶体管的第一端接收数据信号,栅极接收第二控制信号,第二端与所述第五薄膜晶体管的第一端、所述第一薄膜晶体管的第二端连接;

所述第五薄膜晶体管的栅极和所述第六薄膜晶体管的栅极连接后接收使能信号,第二端与所述存储电容的一端连接后接收电源信号;

所述第三薄膜晶体管的第一端与所述第一薄膜晶体管的栅极、所述存储电容的另一端、所述第四薄膜晶体管的第二端连接,栅极与所述第二薄膜晶体管的栅极连接已接收所述第二控制信号,第二端分别与所述第一薄膜晶体管的第一端、所述第六薄膜晶体管的第二端连接;

所述第六薄膜晶体管的第一端分别与所述第七薄膜晶体管的第一端、发光元件的阳极连接;

所述第七薄膜晶体管的栅极接收第一控制信号,第二端与所述第四薄膜晶体管的第一端连接后接收复位电压;

所述第四薄膜晶体管的栅极接收所述第一控制信号；

所述发光元件的阴极接地。

9. 一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法，其特征在于，该方法包括：

获取AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域，所述分布区域至少包括第一区域和第二区域；

在所述第一区域和所述第二区域的单位像素驱动电路中形成不同电容值的存储电容，以使所述第一区域和所述第二区域具有相同的显示亮度。

10. 根据权利要求9所述的方法，其特征在于，当所述第一区域的膜层厚度大于所述第二区域的膜层厚度时，设置在所述第一区域的所述存储电容的电容值大于设置在所述第二区域的所述存储电容的电容值。

一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示技术领域,特别是涉及一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板。

背景技术

[0002] 有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode,OLED)显示面板具有自发光、驱动电压低、发光效率高、响应时间短、清晰度与对比度高、近180°视角、使用温度范围宽等诸多优点,而被广泛地应用于智能手机、平板电脑、全彩电视等。

[0003] OLED显示面板按照驱动方式可以分为无源矩阵(Passive Matrix,PM)型和有源矩阵(Active Matrix,AM)型两大类,其中,有源矩阵有机发光二极管(AMOLED)技术是柔性显示重点发展方向之一。

[0004] AMOLED面板的显示亮度不均问题是AMOLED面板常见的不良问题之一,其中OLED蒸镀制程膜厚不均是导致面板显示亮度不均的成因之一。

[0005] 因此,如何改善膜厚不均而导致的AMOLED面板的显示亮度不均是一个亟待解决的问题。

发明内容

[0006] 本发明主要解决的技术问题是提供一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板,能够改善膜厚不均而导致的AMOLED面板的显示亮度不均的问题,进而提升AMOLED的显示品质。

[0007] 为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种AMOLED面板,该面板至少包括膜层厚度不同的第一区域和第二区域;其中,设置在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中的存储电容具有不同的电容值,以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。

[0008] 为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法,该方法包括:获取AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域,该分布区域至少包括第一区域和第二区域;在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中形成不同电容值存储电容,以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。

[0009] 本发明的有益效果是:本发明的改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板通过获取AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域,分布区域至少包括第一区域和第二区域;在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中形成不同电容值的存储电容,以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。本发明通过不同膜层厚度的区域设置不同的存储电容值,而不同的存储电容值对应的像素点的显示亮度不同,从而能够改善膜厚不均而导致的AMOLED面板显示亮度不均的问题,进而提升AMOLED的显示品质。

附图说明

- [0010] 图1是本发明第一实施例的AMOLED面板的结构示意图；
- [0011] 图2是图1所示的AMOLED面板中单位像素驱动电路的电路原理图；
- [0012] 图3是图2所示的单位像素驱动电路的控制信号时序图；
- [0013] 图4是图2所示的单位像素驱动电路中存储电容的充电路径示意图；
- [0014] 图5是图1所示的AMOLED面板的部分剖面结构图；
- [0015] 图6是本发明第二实施例的AMOLED面板的结构示意图；
- [0016] 图7是线蒸镀源蒸镀简易原理图；
- [0017] 图8是本发明第三实施例的AMOLED面板的结构示意图；
- [0018] 图9是本发明实施例的改善AMOLED面板显示亮度不均的方法的流程图。

具体实施方式

[0019] 在说明书及权利要求书当中使用了某些词汇来指称特定的组件，所属领域中的技术人员应可理解，制造商可能会用不同的名词来称呼同样的组件。本说明书及权利要求书并不以名称的差异来作为区分组件的方式，而是以组件在功能上的差异来作为区分的基准。下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。

[0020] 图1是本发明第一实施例的AMOLED面板的结构示意图。如图1所示，AMOLED面板10包括膜层厚度不同的第一区域A、第二区域B以及按照矩阵形式分布在AMOLED面板10上的多个像素点11，其中，每个像素点11包括单位像素驱动电路111和发光元件112，单位像素驱动电路111用于驱动发光元件112发光以显示对应的像素点11。

[0021] 请一并参考图2，图2是图1所示AMOLED面板中单位像素驱动电路的电路原理图。如图2所示，单位像素驱动电路111包括第一薄膜晶体管M1、第二薄膜晶体管M2、第三薄膜晶体管M3、第四薄膜晶体管M4、第五薄膜晶体管M5、第六薄膜晶体管M6、第七薄膜晶体管M7和存储电容Cst。

[0022] 第二薄膜晶体管M2的第一端接收数据信号Data，栅极接收第二控制信号T2，第二端与第五薄膜晶体管M5的第一端、第一薄膜晶体管M1的第二端连接。

[0023] 第五薄膜晶体管M5的栅极和第六薄膜晶体管M6的栅极连接后接收使能信号EN，第二端与存储电容Cst的一端连接后接收电源信号VDD。

[0024] 第三薄膜晶体管M3的第一端与第一薄膜晶体管M1的栅极、存储电容Cst的另一端、第四薄膜晶体管M4的第二端连接，栅极与第二薄膜晶体管M2的栅极连接以接收第二控制信号T2，第二端分别与第一薄膜晶体管M1的第一端、第六薄膜晶体管M6的第二端连接。

[0025] 第六薄膜晶体管M6的第一端分别与第七薄膜晶体管M7的第一端、发光元件112的阳极连接。第七薄膜晶体管M7的栅极接收第一控制信号T1，第二端与第四薄膜晶体管M4的第一端连接后接收复位电压V1。第四薄膜晶体管M4的栅极接收第一控制信号T1。发光元件112的阴极接地。

[0026] 在本实施例中，第一端、第二端分别为薄膜晶体管的源极和漏极，第一端、第二端也可以分别为薄膜晶体管的漏极和源极。

[0027] 在本实施例中，第一薄膜晶体管M1到第七薄膜晶体管M7为P型薄膜晶体管。在其它实施例中，第一薄膜晶体管M1到第七薄膜晶体管M7也可以为N型薄膜晶体管。

[0028] 在本实施例中，第一薄膜晶体管M1为驱动晶体管；发光元件112为有机发光二极管。

管。

[0029] 在本实施例中,第一控制信号T1为第N-1级扫描信号SCAN[n-1],第二控制信号T2为第N级扫描信号SCAN[n],使能信号EN为第N级控制信号OM[n]。

[0030] 请一并参考图3,图3是图2所示单位像素驱动电路的控制信号时序图。如图3所示,单位像素驱动电路111的工作过程分为初始化阶段B1、数据写入阶段B2和发光阶段B3。

[0031] 在初始化阶段B1,第一控制信号T1为低电平、第二控制信号T2为高电平、使能信号EN为高电平,第四薄膜晶体管M4、第七薄膜晶体管M7导通。此时,第一薄膜晶体管M1的栅极以及发光元件D1的阳极被复位至复位电压V_I。

[0032] 在数据写入阶段B2,第一控制信号T1为高电平、第二控制信号T2为低电平、使能信号EN为高电平,第二薄膜晶体管M2、第三薄膜晶体管M3导通。此时,第三薄膜晶体管M3导通,使得第一薄膜晶体管M1的栅极和第二端短接形成了diode connect(二极管)结构。如图4所示,第二薄膜晶体管M2导通,从第二薄膜晶体管M2的第一端接收的数据信号Data经第二薄膜晶体管M2第二端写入第一薄膜晶体管M1的第一端,经过第一薄膜晶体管M1的diode connect结构对第一薄膜晶体管T1的栅极和存储电容C_{st}进行充电。

[0033] 其中,存储电容C_{st}的充电计算公式为:

[0034] $V_t = V_0 + (V_Q - V_0) * (1 - \exp(-T/RC))$

[0035] 其中,V₀是存储电容C_{st}起始电位,V_Q是充电目标电位,T是充电时间,V_t是在任意时间t的存储电容C_{st}的电位,C是存储电容C_{st}的电容值,R是充电负载。

[0036] 在数据信号Data写入时,充电时间T固定,T为第二控制信号T2处于低电平的时间。存储电容C_{st}的电容值C的大小会影响第一薄膜晶体管M1的栅极电位,而第一薄膜晶体管M1的栅极电位可调节发光元件112的驱动电流的大小,从而调节发光元件112对应的像素点的发光亮度。具体来说,当存储电容C_{st}的电容值C变大时,第一薄膜晶体管M1的栅极电位降低,发光阶段流经发光元件112的驱动电流变大,显示亮度变大。

[0037] 在发光阶段B2,第一控制信号T1为高电平、第二控制信号T2为高电平、使能信号EN为低电平,第五薄膜晶体管M5、第六薄膜晶体管M6导通。此时,发光元件112在驱动电流的驱动下开始发光。

[0038] 在本实施例中,设置在第一区域A和第二区域B的单位像素驱动电路111中的存储电容C_{st}具有不同的电容值,以使第一区域A和第二区域B具有相同的显示亮度。具体来说,当第一区域A的膜层厚度大于第二区域B的膜层厚度时,设置在第一区域A的存储电容C_{st}的电容值大于设置在第二区域B的存储电容C_{st}的电容值。反之,当第一区域A的膜层厚度小于第二区域B的膜层厚度时,设置在第一区域A的存储电容C_{st}的电容值小于设置在第二区域B的存储电容C_{st}的电容值。

[0039] 请一并参考图5,图5是图1所示AMOLED面板的部分剖面示意图。如图5所示,第一区域A和第二区域B包括依次设置在基板131上的缓冲层132和有源半导体层133,设置在有源半导体层133上相互间隔设置的第一栅极A11与第二栅极A11',设置在第一栅极A11和第二栅极A11'上的第一绝缘层134;设置在第一绝缘层134上与第一栅极A11和第二栅极A11'对应设置的第一存储电容C_{st1}和第二存储电容C_{st2};设置在第一存储电容C_{st1}和第二存储电容C_{st2}上的第三绝缘层136;设置在第三绝缘层136上的第一源/漏极B11和第二源/漏极B11',第一源/漏极B11和第二源/漏极B11'贯穿第三绝缘层136、第一绝缘层134与有源半导

体层133接触;其中,第一存储电容Cst1设置在两个第一源/漏极B11之间,第二存储电容Cst2设置在两个第二源/漏极B11'之间。

[0040] 具体来说,第一存储电容Cst1由设于基板131上的第一极板C11、位于第一极板C11上方的第一对向极板C12、夹持于第一极板C11和第一对向极板C12之间的第二绝缘层135构成,第二存储电容Cst2由设于基板131上的第二极板C11'、位于第二极板C11'上方的第二对向极板C12'、夹持于第二极板C11'和第二对向极板C12'之间的第二绝缘层135构成;其中,第一极板C11的面积不同于第二极板C11'的面积,从而使得第一存储电容Cst1的电容值不同于第二存储电容Cst2的电容值。

[0041] 具体来说,当第一极板C11的面积大于第二极板C11'的面积时,第一存储电容Cst1的电容值大于第二存储电容Cst2的电容值。反之,当第一极板C11的面积小于第二极板C11'的面积时,第一存储电容Cst1的电容值小于第二存储电容Cst2的电容值。

[0042] 图6是本发明第二实施例的AMOLED面板的结构示意图。如图6所示,玻璃基板2上设置有多块AMOLED面板20,每个AMOLED面板20包括多个第一区域A2和多个第二区域B2,其中,第一区域A2和第二区域B2间隔设置在AMOLED面板20上。

[0043] 本领域的技术人员可以理解,图6所示的第一区域A2的显示数量为两个、第二区域B2的显示数量为三个,其仅为举例,本发明不以此为限。另外,本发明也不限制第一区域A2和第二区域B2的具体位置。

[0044] 在本实施例中,第一区域A2为线蒸镀源21蒸镀AMOLED面板20时相邻喷嘴蒸镀的重叠蒸镀区域,第二区域B2为单个喷嘴蒸镀的非重叠蒸镀区域,其中,第一区域A2的膜层厚度大于第二区域B2的膜层厚度。

[0045] 请一并参考图7,图7是线蒸镀源蒸镀简易原理图。如图7所示,玻璃基板2和金属掩模板22位置固定,线蒸镀源21沿着玻璃基板2的长边移动,透过金属掩模板22完成OLED发光层的蒸镀。线蒸镀源21是由数个喷嘴(Nozzle)211组成的,通过控制各喷嘴211的温度、蒸镀速率、开关等可进行OLED蒸镀工艺优化。其中,线蒸镀源21的下方设置有加热装置23,可由加热装置23来控制各喷嘴211的温度。

[0046] 由于线蒸镀源21是由多个喷嘴211组成,相邻喷嘴211之间会有重叠蒸镀的情况,因而会出现重叠蒸镀区域212和非重叠蒸镀区域213的膜厚不均匀情况,OLED膜层厚度不均匀,其对应的像素点发光效率也随之不同,造成面板显示亮度不均的问题。

[0047] 在本实施例中,第一区域A2和第二区域B2平行于玻璃基板2的长边设置。换个角度来说,第一区域A2和第二区域B2平行于AMOLED面板20的短边设置。

[0048] 在本实施例中,设置在第一区域A2的单位像素驱动电路中的存储电容的电容值大于设置在第二区域B2的单位像素驱动电路中的存储电容的电容值,使得第一区域A2的像素点的显示亮度高于第二区域B2的像素点的显示亮度,从而弥补由于第一区域A2的膜层厚度大于第二区域B2的膜层厚度使得第一区域A2的显示亮度变低的问题,达到第一区域A2和第二区域B2具有相同的显示亮度。其中,单位像素驱动电路以及存储电容在前面已有详细的描述,在此不再赘述。

[0049] 图8是本发明第三实施例的AMOLED面板的结构示意图。如图8所示,玻璃基板3上设置有多块AMOLED面板30,其中,每个AMOLED面板30包括第一区域A3、第二区域B3和第三区域C3。

[0050] 其中,第一区域A3为线蒸镀源31蒸镀AMOLED面板30时第一蒸镀温度对应的蒸镀区域,第二区域B3为第二蒸镀温度对应的蒸镀区域,第三区域C3为第三蒸镀温度对应的蒸镀区域。在本实施例中,第一蒸镀温度高于第二蒸镀温度,第二蒸镀温度高于第三蒸镀温度,从而使得第一区域A3的膜层厚度高于第二区域B3的膜层厚度,第二区域B3的膜层厚度高于第三区域C3的膜层厚度。在其它实施例中,也可以是第二区域B3的膜层厚度最厚,第一区域A3和第三区域C3的膜层厚度相同且小于第二区域B3的膜层厚度等等。

[0051] 线蒸镀源31对玻璃基板3进行蒸镀的过程中,随着蒸镀的进行,提供给喷嘴的加热温度发生变化,从而使得蒸镀温度发生变化。例如,提供给喷嘴的温度逐步变低,从而使得蒸镀温度逐步变低。此时,每个AMOLED面板30的第一区域A3的蒸镀温度互不相同,每个AMOLED面板30的第二区域B3的蒸镀温度互不相同,每个AMOLED面板30的第三区域C3的蒸镀温度互不相同。

[0052] 在本实施例中,第一区域A3、第二区域B3、第三区域C3平行于线蒸镀源22设置。换个角度来说,第一区域A3、第二区域B3、第三区域C3平行于AMOLED面板30的长边设置

[0053] 在本实施例中,设置在第一区域A3的单位像素驱动电路中的存储电容的电容值最大,设置在第三区域C3的单位像素驱动电路中的存储电容的电容值最小,从而使得第一区域A3、第二区域B3、第三区域C3具有相同的显示亮度。

[0054] 本领域的技术人员可以理解,在其它实施例中,每个AMOLED面板30还可以根据蒸镀区域的温度不同划分为四个区域、五个区域等等,本发明不以此为限。

[0055] 图9是本发明实施例的改善AMOLED面板显示亮度不均的方法的流程图。如图9所示,该方法包括步骤:

[0056] 步骤S101:获取AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域,该分布区域至少包括第一区域和第二区域。

[0057] 在步骤S101中,AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域是有规律存在的,其中,不同膜层厚度可以是由于线蒸镀源蒸镀AMOLED面板存在重叠蒸镀区域或蒸镀温度发生变化而导致的。

[0058] 当不同膜层厚度是由重叠蒸镀区域导致时,第一区域为线蒸镀源蒸镀AMOLED面板时相邻喷嘴蒸镀的重叠蒸镀区域,第二区域为单个喷嘴蒸镀的非重叠蒸镀区域,其中,第一区域的膜层厚度大于第二区域的膜层厚度。

[0059] 当不同膜层厚度是由不同蒸镀温度导致时,第一区域为线蒸镀源蒸镀AMOLED面板时第一蒸镀温度对应的蒸镀区域,第二区域为第二蒸镀温度对应的蒸镀区域,其中,当第一蒸镀温度高于第二蒸镀温度时,第一区域的膜层厚度大于第二区域的膜层厚度。

[0060] 优选地,当第一区域和/或第二区域为多个时,第一区域和第二区域间隔设置在AMOLED面板上。

[0061] 步骤S102:在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中形成不同电容值的存储电容,以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。

[0062] 在步骤S102中,当第一区域的膜层厚度大于第二区域的膜层厚度时,设置第一区域的存储电容的电容值大于第二区域的存储电容的电容值,以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。反之,当第一区域的膜层厚度小于第二区域的膜层厚度时,设置第一区域的存储电容的电容值小于第二区域的存储电容的电容值,以使第一区域和第二区域具有相

同的显示亮度。

[0063] 本发明的有益效果是：本发明的改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板通过获取AMOLED面板中不同的膜层厚度的分布区域，分布区域至少包括第一区域和第二区域；在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中形成不同电容值的存储电容，以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。本发明通过不同膜层厚度的区域设置不同的存储电容值，而不同的存储电容值对应的像素点的显示亮度不同，从而能够改善膜厚不均而导致的AMOLED面板显示亮度不均的问题，进而提升AMOLED的显示品质。

[0064] 以上所述仅为本发明的实施方式，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

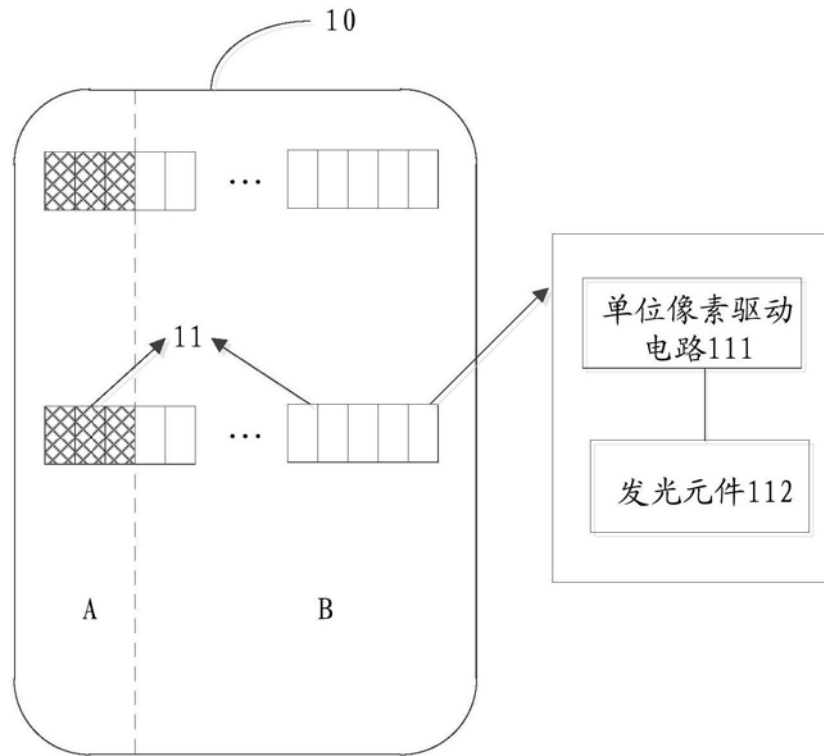


图1

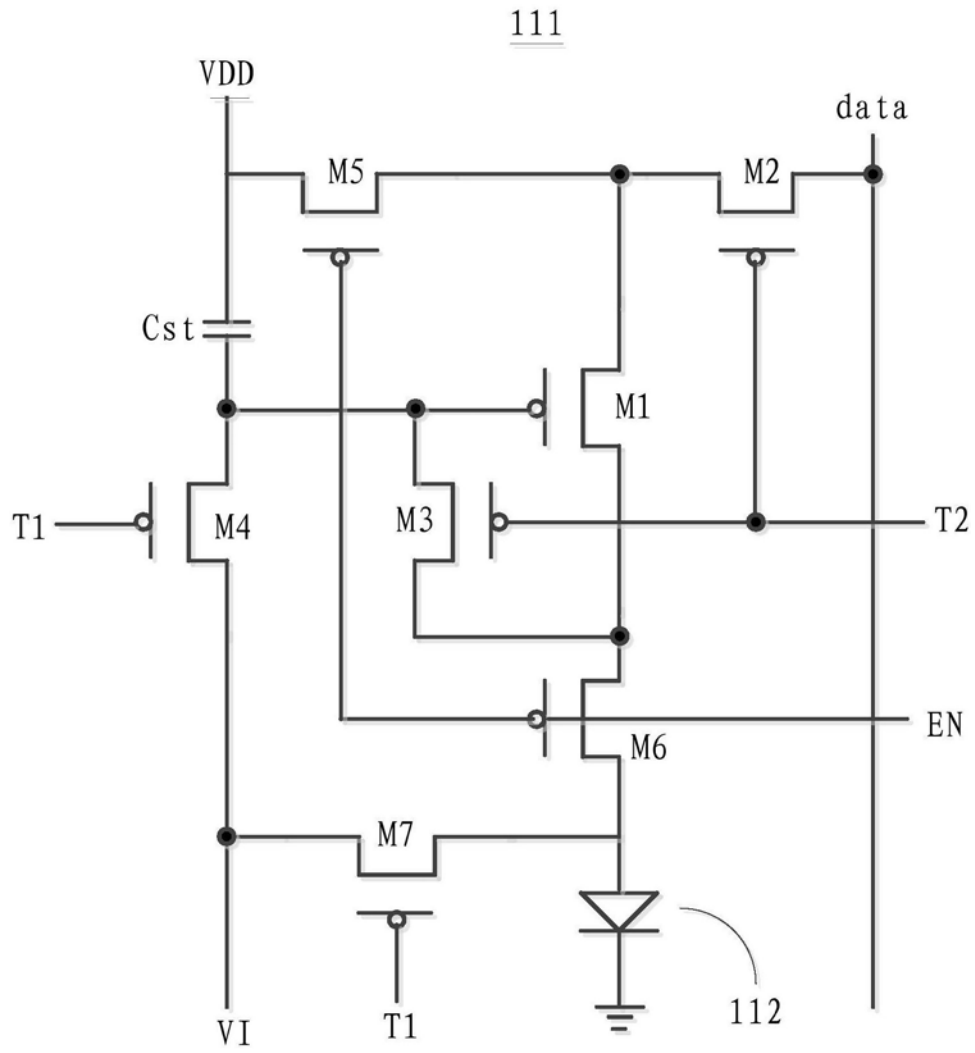


图2

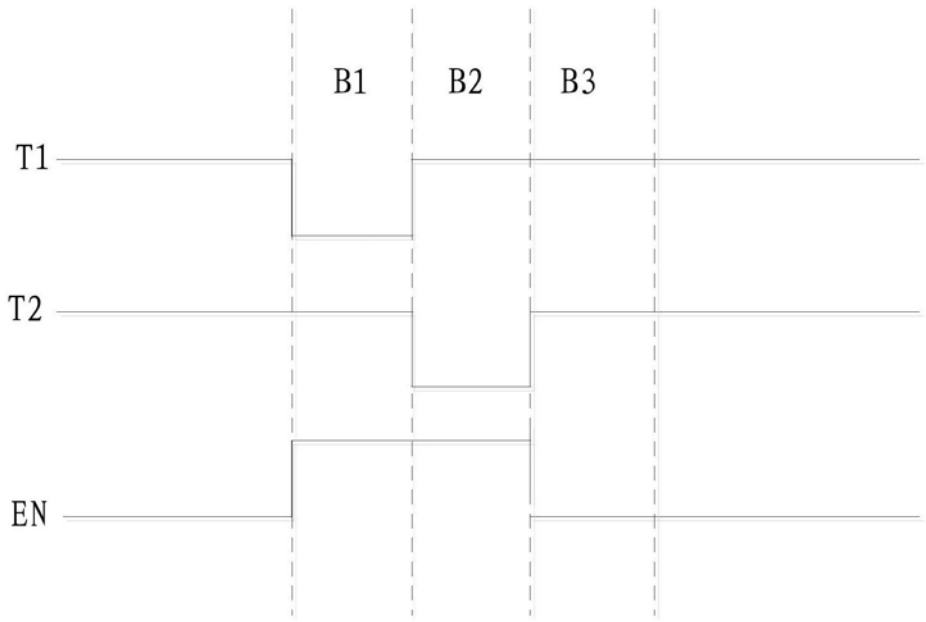


图3

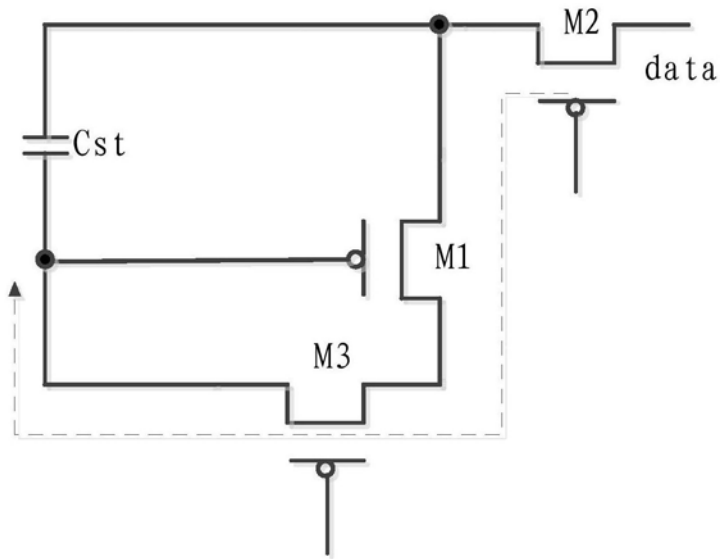


图4

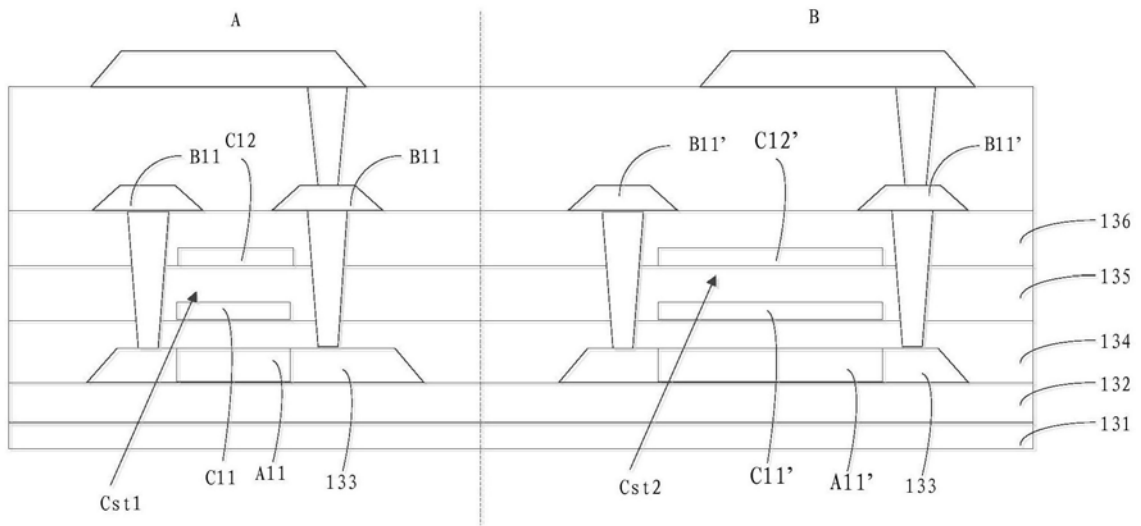


图5

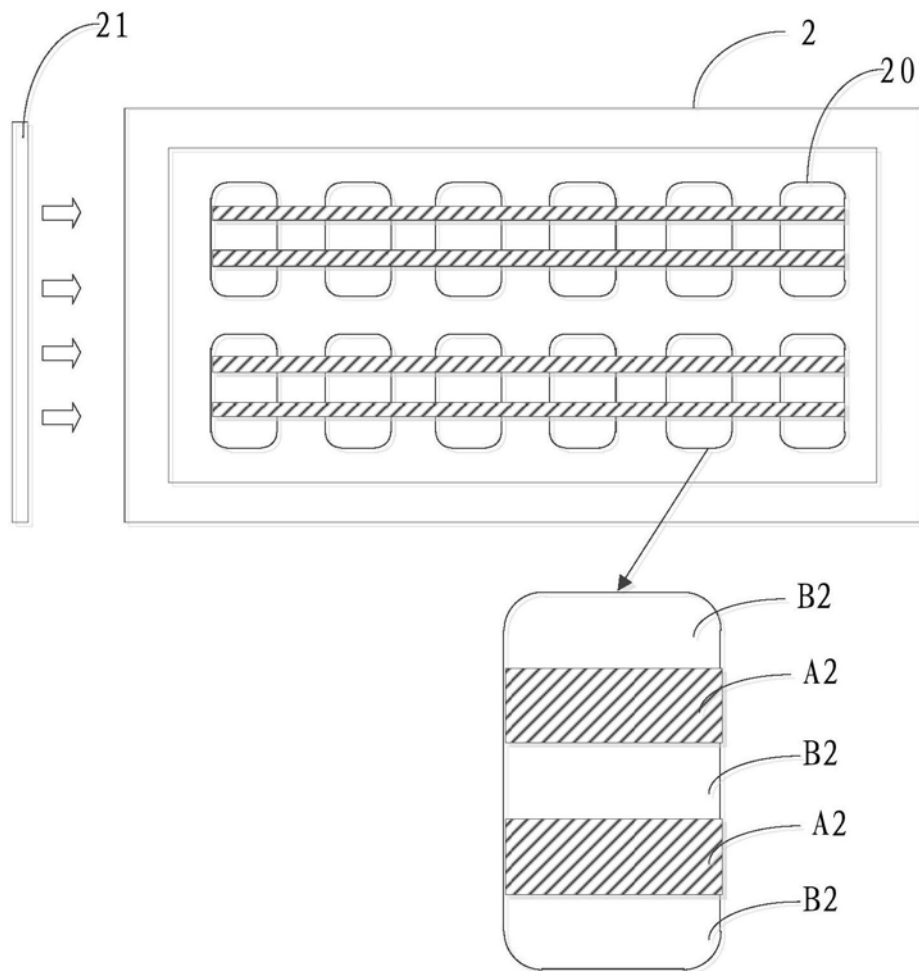


图6

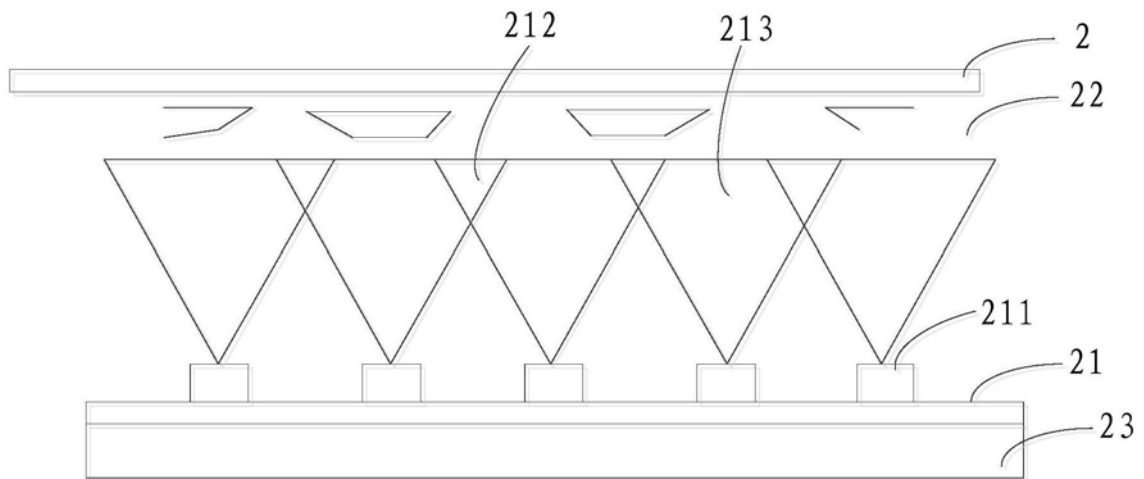


图7

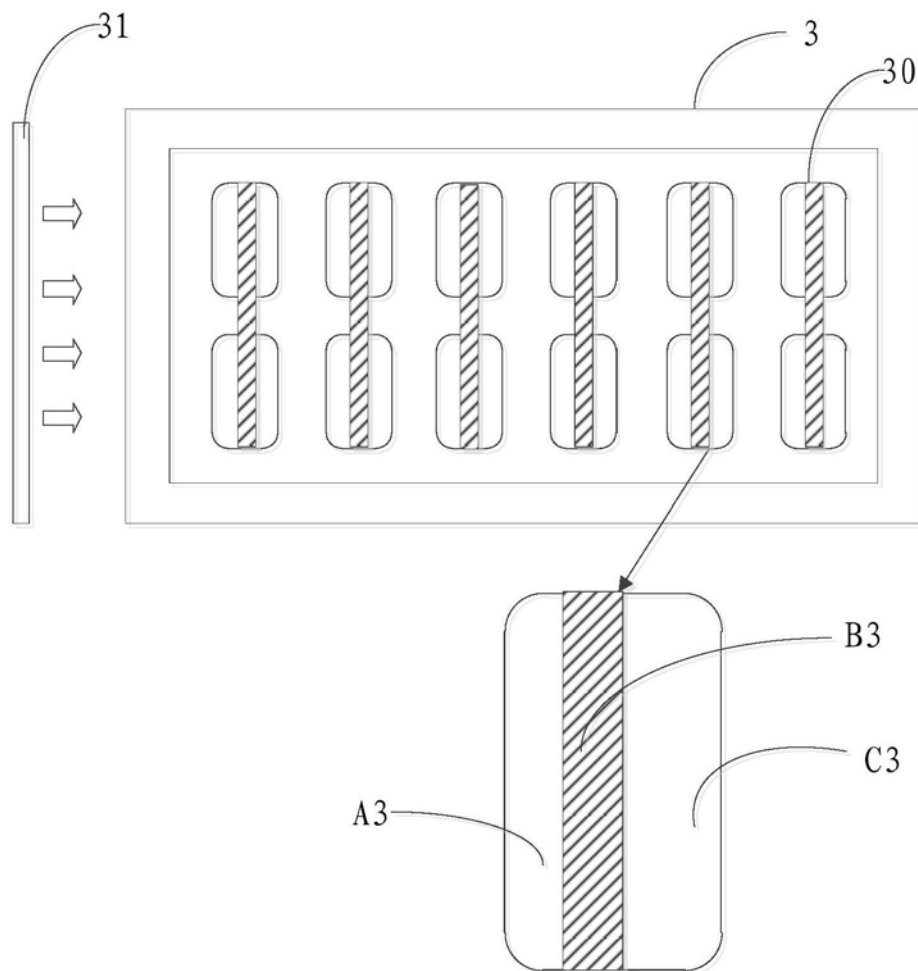


图8

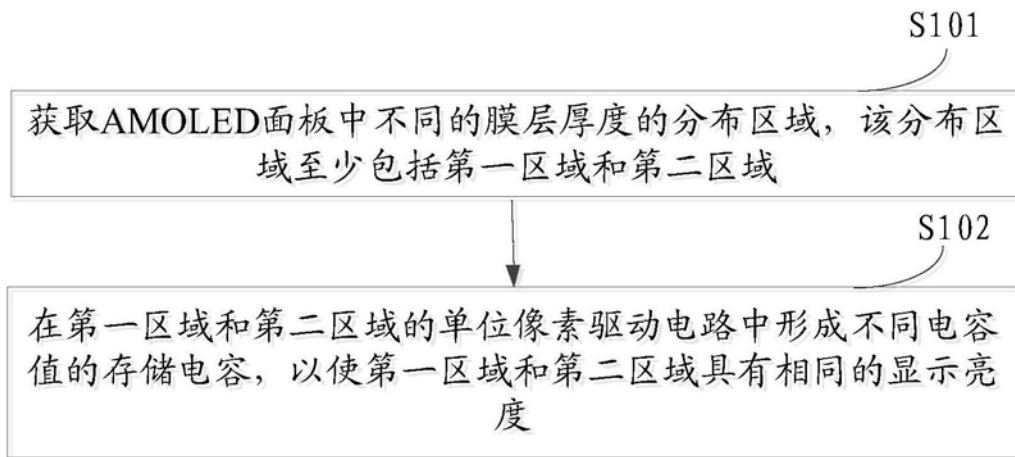


图9

专利名称(译)	一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板		
公开(公告)号	CN108269529A	公开(公告)日	2018-07-10
申请号	CN201810159372.7	申请日	2018-02-24
[标]发明人	李双		
发明人	李双		
IPC分类号	G09G3/3225		
CPC分类号	G09G3/3225 G09G2320/0626 G09G3/3233 G09G2300/0819 G09G2300/0842 G09G2300/0861 H01L27/124 H01L27/1255 H01L27/3265 H01L27/32		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种改善AMOLED面板显示亮度不均的方法及AMOLED面板。该面板至少包括膜层厚度不同的第一区域和第二区域；其中，设置在第一区域和第二区域的单位像素驱动电路中的存储电容具有不同的电容值，以使第一区域和第二区域具有相同的显示亮度。本发明通过不同膜层厚度的区域设置不同的存储电容值，而不同的存储电容值对应的像素点的显示亮度不同，从而能够改善膜厚不均而导致的AMOLED面板显示亮度不均的问题，进而提升AMOLED的显示品质。

